Comment créer son idHAL ?

https://doc.archives-ouvertes.fr/compte-et-profil/

« J'ai déjà un compte HAL ! Pourquoi ai-je besoin d'un IdHAL ? » Le compte HAL sert à se connecter sur la plateforme et à faire des dépôts de documents à l'aide d'un login et d'un mot de passe. L'IdHAL est un identifiant auteur unique, différent du login. Il permet de rattacher une production à un seul profil auteur.

Se connecter à son compte HAL sur <u>https://hal.archives-ouvertes.fr/</u> ou faire un demande de compte sur la <u>page de connexion</u>.

Lors d'une première connexion, on vous demande de paramétrer vos préférences de dépôt. Si vos affiliations automatiques sont à jour, passez à l'étape 3 création de l'idHAL.

1. Préférences de dépôt

Dans l'onglet Mon espace/mon profil, sélectionner les préférences de dépôt et faire vos choix.

HAL							
Informations de mon pro	Informations de mon profil HAL						
Préférences de dépôt							
Préférences de réceptio	n de courriel						
CCSD HAL - Episciences.org -	Sciencesconf.org Support			fr 🚺 Saliha Ouendi 🗸			
	Accueil Dépôt Consultation - Rech	ierche Documentation Mon espace -					
	Modification de votre compte		0				
	Vous pouvez modifier ici vos préférences de dépô	a					
	Mes préférences de dépôt	ront par défaut à chargue nouveau dépôt. Elles seront modifiables lors de voire dépôt.		choisir une vue détaillée permet d'ajouter un			
choisir «oui» pour que	Formulaire de dépôt	En vue simple n'appanaiszent que les méladonnées obligabilies. Vous pouvez naviguer entre les 2 vues lors de votre dépôt. Vue simple O Vue détaillée		projet ANR / européen, un résumé un id ArXiV			
automatiquement	Domaines	Sciences de l'ingénieur [physics]		Sciences pour l'Ingénieur			
renseignées lors des dépôts	Majouter comme auteur	Doil on vous associer automatiquement comme auteur de vos nouveaux dépôts ?		sera rentré par défaut			
Sélectionnez	Affiliation(s)	Veuillez salair le nom ou l'acronyme de votre laboratoire et le sélectionner dans la liste					
l'affiliation IEMN (id : 1066983) et groupe.	Affilier les auteurs automatiquement	ELN Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520 EMR (2021					
EX : UMINF - IEMIN		CMNF Centrale de Micro Nano Fabrication - IEMN CMM - IEMN (2021) - IEMN Hand & Electronique, de Microelectronique et de Nanotechnologie (IEAM) - UMR 8520					

Affiliation(s) Affilier les auteurs automatiquement	Veulliez saisir le nom ou l'acronyme de votre laboratoire et le sélectionner dans la liste	Nouveau 2020 : on peut activer l'affiliation automatique co-auteurs. Toujours vérifier les propositions faites par HAL
	Enregistrer les modifications	

Enregistrer vos préférences de dépôt.

2. Préférences de réception de courriel

HAL	
Informations de mon profil HAL	
Préférences de dépôt	Pour être automatiquement averti par courriel dès qu'un dépôt est mis en ligne, cochez la/les case(s)
Préférences de réception de courriel	Recevoir la confirmation de vos dépôts
Recevoir la confirmation de vos dépôts Oui	Recevoir les notifications lorsque vous êtes
Recevoir les notifications lorsque vous Oui êtes identifié comme co-auteur	identifié comme co-auteur
Modifier mes préférence	es de courriel

Bien activer la case « recevoir les notifications lorsque vous êtes identifié comme auteur » : vous êtes ainsi averti par un mail vous permettant de valider que vous en êtes bien co-auteur : ce dépôt est alors présent dans votre espace et vous pourrez le modifier/le compléter.

3. Création de l'idHAL :

Dans l'onglet Mon espace/mon profil/informations sur mon profil HAL

CCSD HAL - Episciences.org - Sciencescent.org Support	· Berro ·	fr 🔲 Salha Ouenci +
	Mon expano 7 Mon profit	
	CCSD	
	Manana and an ano point (CCS) VIIII (CCI)	
	Male Informations de mon profil HAL	
	Vere name dates MAL : Selle Caused Mon date : Concernent BRM • Cliquer sur créer mon idHAL Langer : Tropics / Modeler mon grafe	
	Préférences de dépôt	
	Préférences de réception de courriel	

Choisir la chaine de caractères souhaitée pour l'idHAL (en général, HAL propose prénom-nom). Attention : une fois enregistré, l'idHAL ne peut plus être modifié. Vous pouvez indiquer si vous le souhaitez d'autres identifiants chercheur (arXiV, idRef,...)

CCSD H	AL - Episciences.org - Sciencesconf.org	Support 👩 🔹	A	fr	🔲 Saliha Ouend
	Accueil Dépôt Consultation - Red	cherche Documentation Mon espace -	PHI		
	Regroupez vos formes auteurs et créez votre Ide	łAL			
	Identifiants				
		* Champs requis			
	IdHAL	Attention, cet identifiant ne pourra plus être modifié par la suite saliha-ouendi	idHAL suggéré		
	Autres identifiants chercheur	Alignez votre IdHAL avec vos autres identifiants chercheurs			,
			1	arXiv• 🕂	arXiV,
	Uris de réseaux sociaux	Ajoutez vos liens vers les réseaux sociaux		arXiv VIAF	^

Puis, rattacher des formes auteurs présentes sur HAL à votre idHAL :

Indiquer une première variante auteur (ex : nom de famille) et cliquer sur rechercher :

Formes auteurs a	ssociées à votre IdHAL		rechercher
Ajouter des formes auteurs	Saliha Ouendi	Q Rechercher les formes auteurs	formes
			auteurs

Vérifier la pertinence des documents en cliquant sur consulter les documents associés à cette forme auteur, icone en haut à droite.

Formes auteurs associées à votre IdHAL

	Ajouter des formes auteurs		Saliha Ouendi		Q Rechercher les for	mes auteurs	
	Résulta	ats				×	
	Authorid 11492246	Nom prénom Ouendi Saliha	Domaine e-mail	Établissement employeur	Consulter les document forme auteur	s associés à cette	Cliquer
Décocher les		Tous / Au Saliha Oue	cun endi. Cassandra Arico. Florent Blanchard. Jean-Louis Codron.	Xavier Wallart. et al Synthesis of T-Nb2O5 thin-films deposited	by Atomic Laver Deposition for	_	consulter les docs
références qu	i	Saliha Oue supercapa	:d electrochemical energy storage devices. Energy Storage Mi andi, Kevin Robert, Didier Stiévenard, Thierry Brousse, Pascal cictors. Energy Storage Materials, Elsevier, 2019, 20, pp.243-2	aterials, Elsevier, 2019, 16, pp.581-588. (10.1016/j.ensm.2018.0/ I Roussel, et al Sputtered tungsten nitride films as pseudocapac 52. (10.1016/j.ensm.2019.04.006). (hal-02187904)	8.022). (hal-02135683)	_	
vôtres		Cassandra pseudocar	I Arico, Kevin Robert, Kevin Brousse, Saliha Ouendi, Camille I pacitance. 232th Electrochemical Society Meeting (ECS232), (Douard, et al Thin film electrodes for fast electrochemical micro Oct 2017, Washington, United States. (hal-02330660)	devices based on redox or intercalati	on	

Cliquer sur Ajouter cette forme à mon idHAL, icone en haut à droite.

Ajouter des f	formes auteurs Saliha Ouendi			Q Rechercher les formes auteurs		
Résulta	ats			×	Cliquer	
Authorid	Nom prénom	Domaine e-mail	Établissement employeur	Ajouter cette forme à mon IdHAL	Ajouter	
11492246	Ouendi Saliha				à idHAL	
 Saliha Ouendi, Cassandra Arico, Florent Blanchard, Jean-Louis Codron, Xavier Wallart, et al Synthesis of T-Nb2O5 thin-films deposited by Atomic Layer Deposition for miniaturized electrochemical energy storage devices. <i>Energy Storage Materials</i>, Elsevier, 2019, 16, pp.581-588. (10.1016/j.ensm.2018.08.022). (hal-02136883) Saliha Quendi, Kevin Pohert, Dirler Stidward, Thierro Brousse, Pascal Powerel, et al. Snuthared tunocten pliride films as pseudocanacitive electrode for on chin micro. 						
	supercapacitors. Energy Storage	<i>Materials</i> , Elsevier, 2019, 20, pp.243-25	2. (10.1016/j.ensm.2019.04.006). (hal-02187904)			

La première forme auteur (ici le nom complet) est bien rattachée à l'idHAL :

Formes auteurs associées à votre IdHAL

Défau	ut	Authorid	Nom prénom	E-mail	Établissement employeur	Actions
0		11492246	Ouendi Saliha			E O
Ajou	uter des fo	ormes auteurs S. Ouendi				Q Rechercher les formes auteurs
Ré	ésultat	s				×
Au	uthorid	Nom prénom	Domaine e-mail	Établiss	ement employeur	Consulter les documents associés à cett forme auteur
11	1203320	Ouendi S				∎ O
		🗹 Tous / Aucun				
		E Elmi, R Cristini-Robbe effect passivation of Si ju	M. Chen, B Wei, R. Bernard, et al Local Sch nctions. Nanotechnology, Institute of Physics,	ottky contacts of embedded A 2018, 29 (28), (10.1088/1361-	g nanoparticles in Al 2 O 3 /SiN x :H s 6528/aac032). (hal-01794379)	tacks on Si: a design to enhance field
		E Elmi, R Cristini-Robbe	M. Chen, B Wei, R. Bernard, et al Local Sch notions. Nanotechnology. Institute of Physics.	ottky contacts of embedded A	g nanoparticles in Al 2 O 3 /SiN x :H s 6528/aac032) /bal-01794058)	tacks on Si: a design to enhance field

Reproduire l'opération avec différentes graphies, pour ratisser large on peut taper uniquement le nom de famille et faire le tri, ou essayer toutes les variantes possibles de son nom (initiale, initiale avec point, noms composés, nom marital, éventuelles variantes d'orthographe erronées utilisées par les co-auteurs, etc...)

Enregistrer lorsqu'on s'est assuré d'avoir balayé toutes les formes auteur. Choisir la forme par défaut à afficher.

Défaut	Authorid	Nom prénom	E-mail	Établissement employeur	Actions
۲	11492246	6 Ouendi Saliha			
0	11203320) Ouendi S			•
Ajouter des	formes auteurs	Ouendi			Q Rechercher les formes auteurs
Résulta	ats				×
Authorid	Nom prénom	Domaine e-mail		Établissement employeur	Action
11168047	Ouendi M.	Autre auteur : ne pas associer			
11042100	oucharm				

Formes auteurs associées à votre IdHAL

Une fois validé, la possibilité de synchroniser avec votre ORCID apparait à l'écran. Prévoir vos identifiants de connexion à orcid.org pour cela.

CCSD	HAL -	Episciences.org - Sciencesco	inf.org Support			0 · A ·	, <i>🍖</i>		fr 🖸 Saliha Ouendi 🕶
		Regroupez vos formes	auteurs et créez votre l	IdHAL	Mon espace •			ſ	Synchroniser avec votre
		Identifiants		* Champs requis					N° ORCID
			IdHAL	saliha-ouendi Récupérer votre ORCID en	vous connectant sur k	e site			
		Autres id	entifiants chercheur	Alignez votre IdHAL avec vos	autres identifiants che	ercheurs		IdRef -	
		Uris	de réseaux sociaux	Ajoutez vos liens vers les rés	eaux sociaux			Blog -	